Prof. G. Pelosi, S. Selleri - Laboratorio di Elettromagnetismo Numerico Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni – Università di Firenze





Lezione 11

Schermi in Campo Vicino

Giuseppe Pelosi - Stefano Selleri Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni Università di Firenze

EM

Sommario della Lezione

- Introduzione
- ❖ Sorgenti ad alta e bassa impedenza
- Schermi per il campo magnetico



Introduzione



Si è valutata l'efficacia schermate per un'onda piana incidente.

Ogni sorgente, a grande distanza, genera un campo che può essere modellato come un'onda localmente piana. Questo è legato al fatto che nei campi radiati i moduli del campo elettrico e del campo magnetico sono in un rapporto ben definito, l'impedenza del mezzo.

Una sorgente a distanza ravvicinata, d'altro canto genera anche campi reattivi, per cui vi è uno sbilanciamento fra campi elettrici e magnetici.

Diventa quindi importante poter valutare separatamente, per una sorgente vicina, il potere schermante relativamente al campo elettrico ed al campo magnetico, separatamente.



Sorgenti ad Alta e bassa Impedenza

Ricordando il campo di un dipolo elettrico corto

$$\mathbf{E} = \begin{cases} E_r = 2\frac{Idl}{4\pi}\zeta_0 k_0^2 \cos\theta \left(\frac{1}{k_0^2 r^2} - j\frac{1}{k_0^3 r^3}\right) e^{-jk_0 r} \\ E_\theta = \frac{Idl}{4\pi}\zeta_0 k_0^2 \sin\theta \left(j\frac{1}{k_0 r} + \frac{1}{k_0^2 r^2} - j\frac{1}{k_0^3 r^3}\right) e^{-jk_0 r} & \mathbf{H} = \end{cases} \\ H_r = 0 \\ H_\theta = 0 \\ H_\theta = 0 \\ H_\phi = \frac{Idl}{4\pi}k_0^2 \sin\theta \left(j\frac{1}{k_0 r} + \frac{1}{k_0^2 r^2}\right) e^{-jk_0 r} \end{cases}$$

Riconosciamo immediatamente come il rapporte tra i moduli di E e di H non sia costante.

Definiamo di conseguenza un'*impedenza d'onda* una grandezza che, in campo lontano, coincida con l'impedenza caratteristica del mezzo e, in campo vicino, renda conto dello sbilanciamento fra campo elettrico e campo magnetico:

$$Z_{w} = \frac{E_{\theta}}{H_{\phi}}$$



Sorgenti ad Alta e bassa Impedenza

Per il dipolo elettrico corto

$$Z_{w} = \frac{E_{\theta}}{H_{\phi}} = \frac{\frac{Idl}{4\pi} \zeta_{0} k_{0}^{2} \sin \theta \left(j \frac{1}{k_{0}r} + \frac{1}{k_{0}^{2}r^{2}} - j \frac{1}{k_{0}^{3}r^{3}} \right) e^{-jk_{0}r}}{\frac{Idl}{4\pi} k_{0}^{2} \sin \theta \left(j \frac{1}{k_{0}r} + \frac{1}{k_{0}^{2}r^{2}} \right) e^{-jk_{0}r}} =$$

$$= \zeta_{0} \frac{j \frac{1}{k_{0}r} + \frac{1}{k_{0}^{2}r^{2}} - j \frac{1}{k_{0}^{3}r^{3}}}{j \frac{1}{k_{0}r} + \frac{1}{k_{0}^{2}r^{2}}}$$

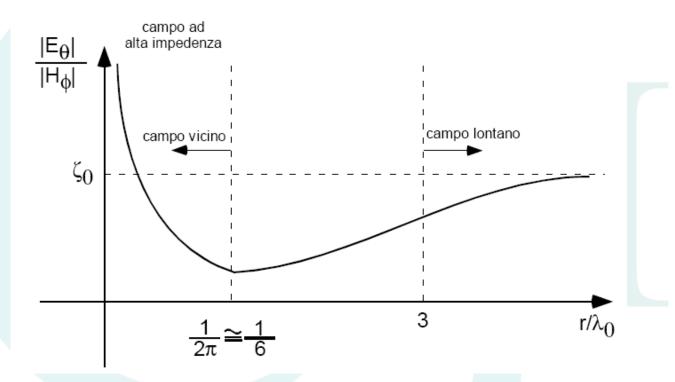
Per distanze molto piccole il termine in r^3 domina e si ha

$$Z_{w} \cong -j\frac{\zeta_{0}}{k_{0}r}$$

L'impedenza d'onda è capacitiva e il suo modulo è elevato, ovvero si ha predominanza di campo elettrico sul magnetico. Siamo in situazione di *alta impedenza*.

Sorgenti ad Alta e bassa Impedenza

In funzione della distanza...





Sorgenti ad Alta e bassa Impedenza

Per la Spira elementare

$$E_r = 0$$

$$E_a = 0$$

$$E_{\theta} = 0$$

$$E_{\phi} = -j\omega\mu_0 \frac{I\pi b^2}{4\pi} k_0^2 \sin\theta \left(j\frac{1}{k_0 r} + \frac{1}{k_0^2 r^2} \right) e^{-jk_0 r}$$

$$\mathbf{H} = \int 2\omega\mu_0 \frac{I\pi b^2}{4\pi\zeta_0} k_0^2 \cos\theta \left(\frac{1}{k_0^2 r^2} - j\frac{1}{k_0^3 r^3}\right) e^{-jk_0 r}$$

$$\mathbf{H} = \begin{cases} H_\theta = j\omega\mu_0 \frac{I\pi b^2}{4\pi\zeta_0} k_0^2 \sin\theta \left(j\frac{1}{k_0 r} + \frac{1}{k_0^2 r^2} - j\frac{1}{k_0^3 r^3}\right) e^{-jk_0 r} \\ H_\theta = 0 \end{cases}$$

$$E_{\theta} = 0 \qquad \qquad \mathbf{H} = \begin{cases} H_{\theta} = j\omega\mu_{0} \frac{I\pi b}{4\pi\zeta_{0}} k_{0}^{2} \sin\theta \left(j\frac{1}{k_{0}r} + \frac{1}{k_{0}^{2}r^{2}} - j\frac{1}{k_{0}^{3}} k_{0}^{2} \right) \\ H_{\phi} = 0 \end{cases}$$

$$Con una definizione duale$$

$$Z_{w} = \frac{E_{\phi}}{H_{\theta}} = \frac{-j\omega\mu_{0} \frac{I\pi b^{2}}{4\pi} k_{0}^{2} \sin\theta \left(j\frac{1}{k_{0}r} + \frac{1}{k_{0}^{2}r^{2}} \right) e^{-jk_{0}r}}{j\omega\mu_{0} \frac{I\pi b^{2}}{4\pi\zeta_{0}} k_{0}^{2} \sin\theta \left(j\frac{1}{k_{0}r} + \frac{1}{k_{0}^{2}r^{2}} \right) e^{-jk_{0}r}}{jk_{0}r^{2} + \frac{1}{k_{0}^{2}r^{2}} - j\frac{1}{k_{0}^{3}r^{3}} e^{-jk_{0}r}} = \zeta_{0} \frac{j\frac{1}{k_{0}r} + \frac{1}{k_{0}^{2}r^{2}}}{j\frac{1}{k_{0}r} + \frac{1}{k_{0}^{2}r^{2}} - j\frac{1}{k_{0}^{3}r^{3}}}$$





Sorgenti ad Alta e bassa Impedenza

Stavolta a dominare vicino alla sorgente è

$$Z_w \cong j\zeta_0 k_0 r$$

L'impedenza d'onda è induttiva e il suo modulo è basso, ovvero si ha predominanza di campo magnetico sull'elettrico. Siamo in situazione di *bassa impedenza*.

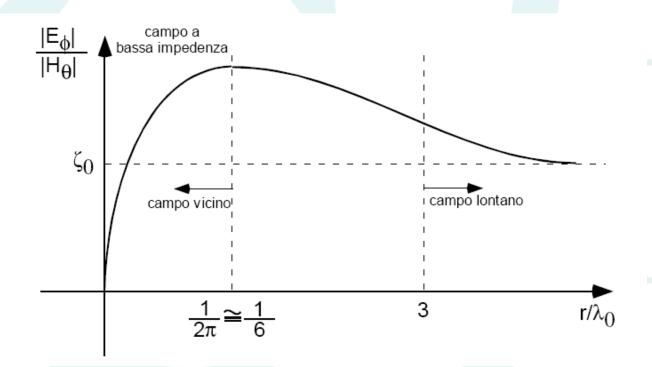
Per quanto riguarda le sorgenti reali le scintille e le scariche elettriche sono affini ai dipoli elettrici corti e sono quindi sorgenti ad alta impedenza

I trasformatori sono invece costituiti da spire su nuclei magnetici e sono tipicamente affini a sorgenti a bassa impedenza



Sorgenti ad Alta e bassa Impedenza

In funzione della distanza...





Sorgenti ad Alta e bassa Impedenza

Anche nel caso di campo vicino possiamo supporre di approssimare l'efficacia di schermatura con la somma dei tre termini:

- Perdite per riflessione
- Perdite per assorbimento
- Perdite per riflessioni multiple

Questo lo si fa sostituendo all'impedenza dello spazio libero l'impedenza d'onda

$$\zeta_0 \to Z_v$$





Sorgenti ad Alta e bassa Impedenza

Perdite per riflessione:

$$R_{dB} \cong 20\log_{10}\left|\frac{Z_{w}+\zeta}{2\zeta}\right| \left|\frac{Z_{w}+\zeta}{2Z_{w}}\right| = 20\log_{10}\frac{\left|Z_{w}+\zeta\right|^{2}}{4\left|Z_{w}\right|\left|\zeta\right|} \cong 20\log_{10}\left|\frac{Z_{w}}{4\zeta}\right|$$

Perdite una sorgente ad alta impedenza è

$$|Z_w| = \frac{\zeta_0}{k_0 r} = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}} \frac{1}{2\pi f \sqrt{\varepsilon_0 \mu_0} r} = \frac{1}{2\pi \varepsilon_0 f r}$$

r è la distanza dallo schermo

$$R_{dB} \cong 20 \log_{10} \left| \frac{\frac{1}{2\pi\varepsilon_{0} fr}}{4\sqrt{\frac{\omega\mu_{0}\mu_{r}}{2\sigma}}\sqrt{2}} \right| = 20 \log_{10} \left(\frac{1}{2\pi\varepsilon_{0} fr} \frac{1}{4} \frac{\sqrt{\sigma_{Cu}\sigma_{r}}}{\sqrt{2\pi}f \mu_{0}\mu_{r}} \right) =$$

$$20\log_{10}\left(\frac{\sqrt{\sigma_{Cu}}}{8\pi\varepsilon_{0}\sqrt{\mu_{0}}\sqrt{2\pi}}\right) + 10\log_{10}\left(\frac{\sigma_{r}}{\mu_{r}f^{3}r^{2}}\right) = 322 + 10\log_{10}\left(\frac{\sigma_{r}}{\mu_{r}f^{3}r^{2}}\right)$$

Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni – Università di Firenze Prof. G. Pelosi, S. Selleri - Laboratorio di Elettromagnetismo Numerico Compatibilità Elettromagnetica I A. A. 2006-07





Sorgenti ad Alta e bassa Impedenza

Perdite una sorgente a bassa impedenza è

$$|Z_w| = \zeta_0 k_0 r = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}} 2\pi f \sqrt{\varepsilon_0 \mu_0} r = 2\pi \mu_0 f r$$

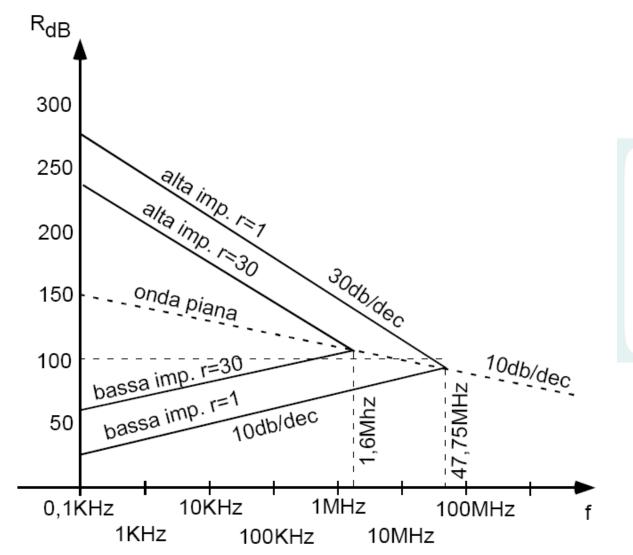
$$R_{dB} \approx 20 \log_{10} \left| \frac{2\pi \mu_{0} fr}{4\sqrt{\frac{\omega \mu_{0} \mu_{r}}{2\sigma}} \sqrt{2}} \right| = 20 \log_{10} \left(\frac{\pi \mu_{0} fr}{2} \frac{\sqrt{\sigma_{Cu} \sigma_{r}}}{\sqrt{2\pi f \mu_{0} \mu_{r}}} \right) = 20 \log_{10} \left(\sqrt{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\mu_{0}} \frac{\sqrt{\sigma_{Cu}}}{2} \right) + 20 \log_{10} \left(\sqrt{\frac{f \sigma_{r} r^{2}}{\mu_{r}}} \right) = 14.57 + 10 \log_{10} \left(\frac{f \sigma_{r} r^{2}}{\mu_{r}} \right)$$





Sorgenti ad Alta e bassa Impedenza

Perdite per riflessione in uno schermo di rame, in funzione di r



Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni – Università di Firenze



EM

Schermi per il Campo Magnetico

Si noti come le sorgenti a bassa impedenza siano legate, a basse frequenze, a basse efficienze schermanti.

Se si considera che le perdite per assorbimento non dipendono dall'impedenza d'onda, e quindi non variano rispetto all'onda piana, unitamente alla considerazione che tali perdite sono basse a basse frequenza si perviene alla conclusione che

Gli schermi sono poco efficaci per sorgenti magnetiche (a bassa impedenza) vicine e a bassa frequenza.

Questo è quindi il caso più interessante da studiare.



EM

Schermi per il campo magnetico

Per sorgenti vicine a bassa impedenza le perdite per riflessione sono trascurabili e l'efficacia schermante è legata alle sole perdite di assorbimento.

Queste perdite sono basse a bassa frequenza, per cui occorre studiare altre tecniche per la schermatura del campo magnetico.

Vi sono due tecniche principali:

- * La deviazione del campo magnetico tramite materiali ad alta permeabilità
- * La generazione di un flusso opposto tramite spire in corto circuito

Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni – Università di Firenze



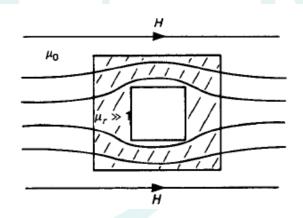


Schermi per il campo magnetico

deviazione del campo magnetico

Un materiale ad alta permeabilità offre per le linee di campo magnetico un percorso a bassa riluttanza.

Le linee tenderanno quindi a concentrarsi nel mezzo ferromagnetico e a non interessare la cavità interna







deviazione del campo magnetico

Vi sono però due fattori che limitano l'applicabilità della tecnica:

- La permeabilità di un mezzo ferromagnetico è una funzione decrescente della frequenza
- La permeabilità di un mezzo ferromagnetico è una funzione decrescente dell'intensità di campo

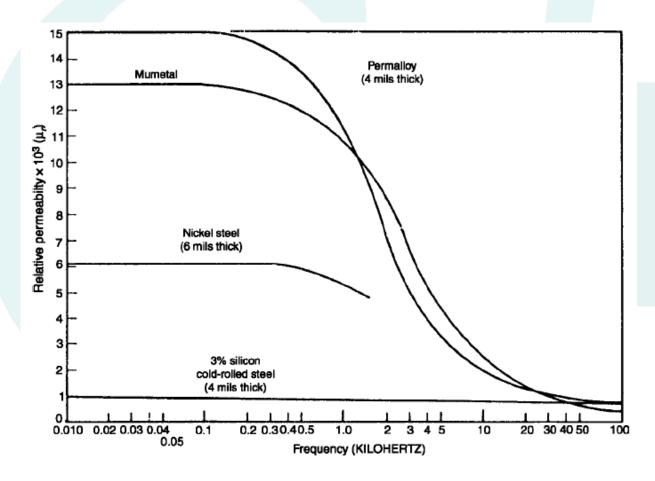
I produttori di materiali ferromagnetici tendono quindi a fornire il valore di permeabilità a una frequenza fissata e relativamente bassa. Tipicamente 1kHz.



Schermi per il campo magnetico

deviazione del campo magnetico

Esempio di comportamento della permeabilità in funzione della frequenza







deviazione del campo magnetico

Si noti come, sotto il kHz le lege speciali presentino altissime permeabilità, mentre, sopra 20kHz praticamente tutte le leghe hanno lo stesso comportamento dell'acciaio laminato a freddo.

Di conseguenza le schermature degli alimentatori (che sono sorgenti a bassa impedenza, a causa delle spire dei trasformatori, principalmente interessate dai campi magnetici) vengono fatte in acciaio

La frequenza di switching degli alimentatori è infatti tipicamente dell'ordine dei 20-100kHz per cui le lege come il Mumetal, molto costose, non presentano alcun significativo vantaggio di schermatura.

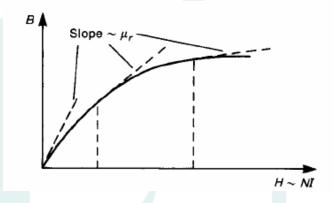
D'altro canto la frequenza di rete a 60Hz può essere efficacemente schermata dal Mumetal, soprattutto se i campi sono così intensi da portare in saturazione il materiale ferromagnetico.





deviazione del campo magnetico

La saturazione provoca un abbassamento della permeabilità e, di conseguenza, delle capacità schermanti



La pendenza del grafico $\mathbf{B} - \mathbf{H}$ è proporzionale alla permeabilità.

La permeabilità fornita dai costruttori, oltre che essere a 1kHz, è pure la *permeabilità iniziale*, ovvero la pendenza iniziale (massima!) della curva





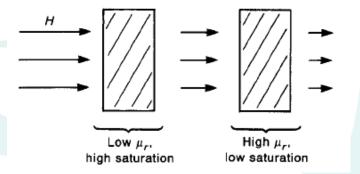
deviazione del campo magnetico

Il Mumetal, quindi, che sembrerebbe ottimale per il suo alto valore di permeabilità a 60Hz potrebbe entrare in crisi per le alte correnti, e quindi campi, legate all'alimentazione di rete.

Inoltre più alta è la permeabilità iniziale, più è facile arrivare alla saturazione.

Il problema può essere affrontato con una doppia schermatura magnetica. La prima con un materiale a permeabilità relativamente bassa e che non saturi facilmente

La seconda con un materiale a permeabilità alta che non vada però in saturazione grazie al fatto che parte del campo magnetico è già stato schermato.



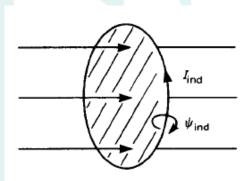


EM

Schermi per il campo magnetico

generazione di un flusso opposto

Una spira cortocircuitata posta in aria risponde, in presenza di un flusso di induzione magnetica, con una corrente che a sua volta genera un flusso di induzione magnetica che tende ad annullare il flusso impresso.



Vi è quindi una generale diminuzione del valore del ccampo magnetico internamente alla spira.

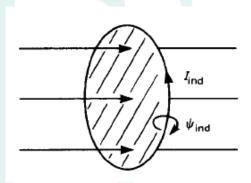


EM

Schermi per il campo magnetico

generazione di un flusso opposto

Una spira cortocircuitata posta in aria risponde, in presenza di un flusso di induzione magnetica, con una corrente che a sua volta genera un flusso di induzione magnetica che tende ad annullare il flusso impresso.



Vi è quindi una generale diminuzione del valore del campo magnetico internamente alla spira.

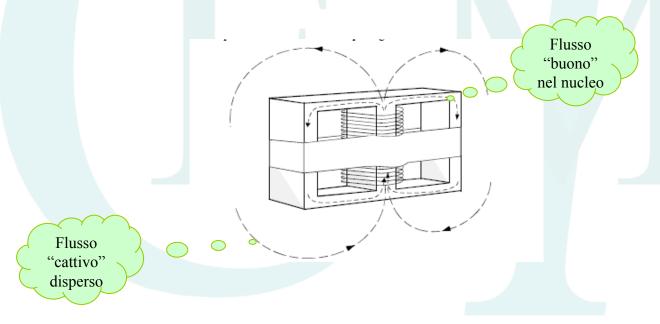




generazione di un flusso opposto

Questa tecnica è utile ancora una volta per gli alimentatori che, come abbiamo visto, sono particolarmente critici.

L'alimentatore è costituito da un nucleo di acciaio laminato che forma il circuito per il flusso magnetico





generazione di un flusso opposto

Il flusso disperso, responsabile delle EMI, è un'induzione magnetica presente fuori dal nucleo a bassa riluttanza.

Un loop conduttivo posto immediatamente a contatto col nucleo presenta, attraverso di esso, un flusso di induzione magnetica che è nullo per la parte "buona", che si richiude dentro al nucleo, e non nullo per la parte "cattiva" che si richiude in aria.

Di conseguenza le correnti che si instaurano su questo anello tendono ad annullare questo flusso "cattivo"

